福井大学 工学部 研究報告 第24巻 第2号 昭和51年9月

CdCl2-CdBr2 混晶の発光

中川英之•林 敬治•松本弘明

Luminescence of CdCl₂-CdBr₂ Solid Solutions

Hideyuki Nakagawa, Keiji Hayashi, Hiroaki Matsumoto

(Received Apr. 15, 1976)

Studies of optical absorption and luminescence were carried out on $CdCl_2$ -CdBr₂ solid solutions in the whole concentration range. Three emission bands appear in the regions of 2.2 eV (Y-emission), 2.5 eV (G-emission) and 3.5 eV (UV-emission). With increasing the concentration of CdBr₂, the UV- and the Yemission bands increase their intensities and shift toward the low energy side to reach finally locations of intrinsic emission bands at 3.30 eV and 2.15 eV, respectively, in pure CdBr₂, whereas the G-emission band, which is associated to the isolated Br⁻ in the CdCl₂ lattice in the case of the very low concentration of CdBr₂, diminishes its intensity gradually. It is proposed that the initial states of these luminescence are the relaxed excitonic states of the form $(Cd^{2+}X_{-6}^{-})$ -complex molecular ions, where X⁻ is the halogen ion, and that the G- and the UV-(orY-) emission bands are interpreted as those of excitons trapped at the Cl⁻-rich region and at the Br⁻-rich region in the crystals, respectively.

1. 序

典型的な層状イオン結晶であるカドミウムハライド 結晶⁽¹⁾ (CdCl₂, CdBr₂及びCdI₂) に於ける励起子は 強い局在性を示し⁽²⁾,その基礎吸収領域での光学的励 起に伴い,ストークス・シフトの大きい一本または二 本の発光帯が観測される⁽³⁾。しかし,この発光の始状 態である緩和励起子状態がどのようなものであるかは 未だ明らかにされていない。

CdCl₂または CdBr₂に不純物として Br⁻または I⁻を 少量添加すると, 夫々の母体の基礎吸収端に添加不純 物による吸収帯が現われ^(3,4), この吸収帯での励起に より母体結晶の固有発光と同様のストークス・シフト の大きい発光帯が現われる^(8,5)。これらの発光は添加 不純物に特有のものであり,以下ではハロゲン不純物 発光と呼ぶ。

上記の固有発光とハロゲン不純物発光との関連性を 明らかにする事は、緩和励起子状態とハロゲンイオン との係わりを調べる上で重要であり、本研究では、全 率固溶混晶である CdCl₂-CdBr₂混晶を用いて、CdCl₂ 中のBr⁻不純物による発光と CdBr₂の固有発光との関 係を調べた。

CdBr₂結晶をその基礎吸収領域の紫外光で励起する

* 電子工学科

と,液体ヘリウム温度(LHeT)では3.30 eV にピー クを持つ単一の発光帯が観測される。この 3.30eV 発 光は試料温度の上昇に伴い60K近辺で急激に減少し, それに代って 2.15eV にピークを持つ別の発光帯が成 長する⁽⁶⁾。この2.15eV発光は,160K以上の温度で熱 的に消光する。これらの発光は、①CdBr2の基礎吸収 領域でのみ強く励起される, ②CdBr₂に含まれている 主な不純物イオンである Pb²⁺, I⁻ による発光とはエ ネルギー位置及び温度依存性が異っており,またこれ らの不純物イオンの量が少ない程強く現われる。③発 光強度の温度依存性が単純な熱活性化型を示し、エネ ルギー伝達による未知不純物の発光であるとは考え難 い等の理由によりCdBr₂結晶の固有発光であり、その 始状態は緩和励起子状態であると考えられる。また発 光が大きなストークス・シフトを示すことはCdBr2結 晶での励起子の局在性が強い事を意味するが,この事 は励起子吸収端スペクトル(Urbach尾部)の解析か ら得られる結果とよく対応している(2)。

CdCl₂結晶に少量のCdBr₂を添加すると,添加され たBr⁻による吸収帯がCdCl₂基礎吸収端領域の5.68eV に現われる^(3,4)。この吸収帯の紫外光で励起すると き、2.65eV にビークを持つ単一の発光帯が観測され る^(3,5)。この発光は①CdCl₂ 中の孤立Br⁻に依る吸収 帯位置のみで強く励起される, ②Br⁻の濃度増加に伴 い強くなる, ③CdCl₂の基礎吸収領域での発光やCd Cl₂ 中の残留不純物I⁻やPb²⁺による発光とはエネルギ ー位置温度依存性が違っている,④上記のCdBr₂結晶の偏析 によるとは考えられない等の理由によりCdCl₂結晶中 に孤立して存在するBr⁻に依るものである事は確かで ある。

この論文では CdCl₂-CdBr₂ 混晶中の CdBr₂ の濃度 (以下この値を mol% でXと記す)を0~100mol% の全範囲にわたって変えたとき,上記の Br⁻不純物発 光及び CdBr₂固有発光が示す振舞いを詳細に調べた結 果を述べ,これをアルカリハライド系や銀ハライド系 と比較検討し、カドミウムハライドに於ける励起子の 緩和機構について考察を行う。

2. 実 験

2.1. 試料

 $CdCl_2-CdBr_2混晶はStockbarger-Bridgeman法$ により製作された。原料には市販の特級試薬 $CdCl_2 \cdot \frac{5}{2}H_2O$ 及び $CdBr_2 \cdot 4H_2O$ を脱水して用いた。全濃度 領域 (X=0~100mol%) で比較的良質の単結晶が得 られたが、結晶中の濃度分布は均一ではないため、測定に用いられた各々の試料について濃度検定を行った。これは水溶液中のBr-による吸収スペクトルを測定する事により行なわれた^(T)。水溶液中のBr-による吸収スペクトルは200nmにピークを持ち、これは181 nmにピークを持つCl-による吸収帯から分離して観測できる。実際には既知濃度の試料を用いて図1に示すような較正曲線を作成し、それとの比較により検定が行なわれた。この吸収測定はHITACHI-EPS-3T分光光度計により行なわれた。



Fig. 1. Calibration curve for the concentration of CdBr₂ in the CdCl₂-CdBr₂ mixed crystal vs optical density of 200nm absorption band of the water solution of the crystal.

> Optical density is measured for the water solution which contain the $CdCl_2$ - $CdBr_2$ sample with the concentration of 18 mg/1. Water solution is held in the quartz cell 1 cm thick for optical absorption measurement.

2.2. 発光の測定

試料結晶は c 軸に垂直な劈開面に沿って劈開され, 約10×10×1mm³の大きさに切り出され, 銅製のサン プルホルダーに取り付けられた。試料はこのサンプル ホルダーからの熱伝導により冷却された。励起光は結 晶の c 軸に沿って入射され, 発光はそれと垂直な方向 から観測された。発光スペクトル及び励起スペクトル の測定方法は以前の報告で述べたものと同 じである が^(3,6), スペクトルの単色バンド幅は夫々 60A及び30 Aである。

2.3. 吸収の測定

 $CdCl_2$ 中の孤立 Br⁻による吸収スペクトルの測定は 単結晶を用いて行なわれた。 $CdCl_2$ -CdBr₂ 混晶及び CdBr₂の吸収スペクトルは,室温に保たれた石英基板 上に真空蒸着法により作られた薄膜を用いて測定され た。測定は全て液体窒素温度(LNT)で HITACHI-EPS-3T分光光度計を用いて行なわれた。

3. 実験結果

CdBr₂に於ける第一励起子吸収帯の 5.18eV紫外光 で励起したとき得られる発光スペクトルを図2に示 す。実線はLHeTで,破線は LNT で観測されたもの



Fig. 2. Intrinsic emission spectra of CdBr₂ measured at LHeT (solid line) and LNT (broken line) respectively. UV light of 5.18 eV in the 1 st exciton absorption range is used for excitation of the crystals. Intensity of each spectrum is normalized as unity at the intensity maximum.

である。これらの発光帯のピーク位置は 3.30eV 及び 2.15eV であり, その強度は 60K近辺で急激に入れか わる。 2.15eV 発光に対する励起スペクトル(破線) と蒸着薄膜について 測定された 吸収 スペクトル(実 線)を図3に示す。 吸収スペクトルに於ける 5.18eV 及び 5.76eV のピークは励起子吸収帯であり, これら は, いわゆるハロゲン・スピン軌道ダブレットである と考えられている⁽⁸⁾。図3に於ける鎖線は単結晶につ いて測定された CdBr₂の基礎吸収領域に於い てのみ強く励起されており, CdBr₂の固有発光帯であ る事を示している。 3.30eV 発光に対する励起スペク トルの振舞いもほぼ同じである。

図4には LHeT (実線) 及び LNT (破線) で測定



Fig. 3. Excitation spectrum (broken line) of CdBr₂ for the 2.15 eV emission measured at LNT, absorption spectrum (solid line) of the CdBr₂ thin film evapolated on the quartz plate, and absorption spectrum (dotted line) of the CdBr₂ single crystal.



Fig. 4. Emission spectra of CdCl₂:Br (concentration of Br⁻ is 1 mole percent) measured at LHeT (solid line) and LNT (broken line) respectively. UV light of 5.68 eV in the absorption band due to the Br⁻ impurities is used for excitation of the crystals.

された CdCl₂:Br の発光スペクトルを示す。 励起は CdCl₂中の孤立Br⁻による5.68eV吸収帯の紫外光で行 なわれた。発光帯としては2.65eV にピークを持ち幅の 広いものが一本現われるのみであり、CdBr₂の場合の ように, 試料温度により別の発光帯と入れかわるとい う現象は観測されない。図5には 2.65eV 発光に対す る励起スペクトル(破線)と、単結晶試料を用いて測 定された吸収スペクトル(実線)を示す。5.68eV に ピークを持つ吸収帯は CdCl₂中の孤立Br⁻によるもの



Fig. 5. Excitation spectrum for 2.60 eV emission of CdCl₂:Br (1 mole percent) measured at LNT (broken line) and absorption spectrum of Cd Cl₂:Br (0.1 mole percent) single crystal (solid line). Absorption band of 5.68 eV in the spectrum is due to the Br- and sharp rise of absorption near 5.8 eV shows the fundamental absorption edge of the crystal.

であり, 5.8eV 近辺の急峻な 立上りは CdCl₂の基礎 吸収端である。この図より2.65eV発光は 5.68eV吸収

帯の位置のみで強く励起されており,不純物 Br-によ るものであることがわかる。

上記の CdBr₂固有発光とBr⁻不純物発光との関係を 調べる事により、ハロゲンイオンの違いが固有発光に どのような影響を与えるかを明らかにする目的で, CdCl₂-CdBr₂混晶に於ける発光スペクトルをLNT及 び LHeTに於いて測定した。図6に LNT で測定され た CdCl₂-CdBr₂ 混晶の発光スペクトルを示す。 この 図で発光強度はスペクトルの下の面積が一定値になる ように規格化されており、また夫々のスペクトルに対 応する CdBra 濃度 X の値は前章で述べた方法により 検定されたものである。 励起はX=1mol% の場合に 5.64eV の位置で行なわれているのを除き, 他は全て 5.18eV 紫外光で行なわれた。図から濃度Xの増加に 伴い, Br-不純物発光スペクトルが徐々に CdBr2固有 発光に変化してゆく様子がわかる。しかしこの変化 は, 2.5eV 近辺の発光帯(以下G発光と呼ぶ)と2.2 eV 近辺の発光帯(以下Y発光と呼ぶ)の相対強度が 濃度Xの値に応じて変化する事によるものであり, Br-不純物発光帯が単純に移動して CdBr2固有発光に なるのではない。この事はLHeTに於けるスペクトル に於いて更に明確に示される。図7にLHeTで測定さ れた混晶の発光スペクトルを示す。この図に於いても



Fig. 6. Emission spectra of CdCl₂-CdBr₂ mixed crystals measured at LNT. Concentration of the CdBr₂ in the crystals are shown in the figure as X in mole percent. Crystals are excited with 5.18 eV UV light except the spectrum a which corresponds to the excitation with 5.64 eV UV light. Spectra are normalized so as the area under the curves are equal.



Fig. 7. Emission spectra of CdCl₂-CdBr₂ mixed crystals measured at LHeT. Concentration of the CdBr₂ in the crystals are shown in the figure as X in mole percent. Crystals are excited with 5.18 eV UV light except the spectrum a which corresponds to the excitation with 5.64 eV UV light. Spectra are normalized so as the area under the curves are equal.

図6と同じ規格化がなされており、Xの値及び励起位 置も図6の場合と同じである。濃度Xの増加に伴いG 発光成分は低エネルギー側に移動すると共にその強度 は単調に減少するのに対し、3.5eV近辺に現われる発 光帯(以下UV発光と呼ぶ)は徐々に成長すると共に 低エネルギー側へ移動し、X=100mol%では遂にCd Br2固有発光帯となる。即ち不純物 Br⁻に関係する発 光成分とCdBr2固有発光と密接な関係を持つ発光成分 とが濃度Xに応じて互いに競合している事がわかる。 尚、G発光成分が X=75mol% という高濃度領域に まで残っている事は、この発光成分が CdCl2結晶中に 孤立して存在する Br⁻のみに依るものではなく、Br⁻ ダイマー(dimer)等のクラスター(cluster)の存 在にも関係しているものと考えられる。

これらの発光に対する励起スペクトルの振舞いを述 べる前に, CdCl₂-CdBr₂ 混晶の吸収スペクトルを図 8に示す。これらのスペクトルは室温の石英基板上に 真空蒸着された薄膜についてLNTで測定されたもの である。蒸着薄膜は図6,図7の発光スペクトルの測 定に用いられた結晶の一片を真空中で瞬間的に溶融し て作られており,図中に示されている濃度Xの値はこ

の結晶片のものである。図中の矢印は Br-による各吸 収成分の中心位置またはピーク位置を示しており,X = 0 mol%, 即ちCdCl2のスペクトルに於ける5.68eV 位置の矢印Aは、単結晶試料について測定された孤立 Br⁻による吸収帯のピーク位置を示す。濃度Xの増加 に伴い, Br-による吸収成分は徐々に低エネルギー側 に広がり, X=75mol% 近辺では高エネルギー側に 別の吸収構造が現われる。以後この二本の吸収構造は CdBr₂ (X=100mol%) のハロゲン・スピン軌道ダ ブレット B₁, B₂ に成長してゆく 様子がわかる。 Cd Br2の吸収スペクトルは文献(®)に見られるものと同じ であり、また単結晶を用いて測定された反射スペクト ルから得られるものともほぼ一致している⁽⁹⁾。しか し、混晶系での吸収スペクトルの構造は極めて不明瞭 であり、これらからエネルギー状態の変化の様子を議 論することは不可能である。

図9にLNTで測定された励起スペクトルを示す。 受光エネルギー位置は図6に示されている各発光スペ クトルのピーク近辺であり,また図中の矢印は図8に 示されているものと同じエネルギー位置を示す。X= 1mol%の試料ではBr-による5.68eV近辺でのみ強く



Fig. 8. Absorption spectra of $CdCl_2-CdBr_2$ thin films evapolated on the quartz plates measured at LNT. Concentration of the $CdBr_2$ in the films are shown in the figure as X in mole percent. Arrows in the figure show the positions of absorption bands associated to $CdBr_2$. Arrow A shows the position of the absorption band peak due to the isolated Brmeasured on the single crystal. Arrows B₁ and B₂ show the positions of the halogen doublet of $CdBr_2$.

励起されているが濃度Xの増加に伴い,発光が強く励起されているが濃度Xの増加に伴い,発光が強く励起されるエネルギー領域は低エネルギー側に拡がって くる事がわかる。このことは,Br⁻吸収成分の成長と よく対応している。この図に於ける発光には図6の説 明でも述べた様にG発光とY発光の両成分が含まれて おり,これら両発光の夫々に対する励起スペクトルの 特徴は出ていない。そこでBr⁻不純物発光とCdBr₂固 有発光との夫々に関係する発光帯が十分に分離して観 測されるLHeTでのG発光及びUV発光に対する励起 スペクトルを測定した。図10にX=16mol%の試料に ついてLHeTで測定された励起スペクトルを示す。 実線はUV発光,破線はG発光に対するものである。 この図では夫々のスペクトルの強度が最大になる所を 1になるように規格化してあるが、実際にはUV発光



Fig. 9. Excitation spectra for the emission bands shown in the Fig. 6 measured at LNT. Concentration of $CdBr_2$ in the samples are shown in the figure and arrows in the figure show the same positions as in the Fig. 8.

及びG発光は 5.18eV の位置で図7に示されているよ うな強度比になる。図から明らかなように、G発光は 5.68eVの Br- 不純物吸収帯近辺で強く 励起されてい るのに対し, UV発光はその低エネルギー側で強く励 起されている。このことは両発光が異なる光学吸収に 基づくものである事を示しており、従って異種の発光 中心が原因をなしている事を示す。このUV及びG発 光に対する励起スペクトルの相違は濃度Xが大きくな るに従って少なくなり, X=33mol%では図11で示す ようにG発光が低エネルギー側で強く励起されるよう になると共に, UV発光に対する励起スペクトルも高 エネルギー側に広がってくる。更にX=75mol%では 図12で示すように両者の差は殆んどなくなる。この振 舞いは、G発光がBr⁻クラスターにも関係している事 を示すと共に、 CdBr₂ における励起子との類似が濃 度増加と共に強くなる事にも対応しているものと考え



Fig. 10. Excitation spectra for the UV-emission (solid line) and G-emission (broken line) of CdCl₂-CdBr₂ (16mole percent) measured at LHeT. Each spectrum is normalized so as the intensity of the maximum intensity is unity. Real intensity ratio between UV-and G-emissions at 5.18 eV can be obtained from the emission spectra in Fig. 7.



Fig. 11. Excitation spectra for the UV-emission (solid line) and G-emission (broken line) of CdCl₂-CdBr₂ (33 mole percent) measured at LHeT. Normalization and real intensity ratio of the spectra are in the same ways as are shown in Fig. 10.

られる。

4. 考 察

CdCl₂-CdBr₂ 混晶系に於いては,図6及び図7に示 されているように三本の発光帯が現われる。即ち濃度 Xの値が小さいときに強く観測される2.4~2.6eV 領 域のG発光帯と,濃度Xの増加と共に強くなる3.3~



Fig. 12. Excitation spectra for the UV-emission (solid line) and G-emission (broken line) of CdCl₂-CdBr₂ (75 mole percent) measured at LHeT. Normalization and real intensity ratio of the spectra are in the same ways as are shown in Fig. 10.

3.6eV 領域のUV発光帯(LHeT) 及び 2.1~2.2eV 領域のY発光帯が存在する。

G発光帯はX \leq 1mol%の低濃度領域では CdCl₂ 結 晶中に孤立して存在する Br⁻に依るものであると考え てよいが, X>75mol%の高濃度領域でも観測されて おり,このような場合には孤立 Br⁻によるものとは考 え難い。また図7に於けるスペクトル a (X=1mol %)からスペクトル b (X=16mol%) への変化は, 発光帯が低エネルギー側へ単純に移動していると考え るよりも,2.65eV にピークを持つ孤立 Br⁻による発 光帯の強度が減少し,低エネルギー側に別の発光帯が 成長していると考える方が自然である。この低エネ ルギー 側発光成分の原因としては,Br⁻ダイマー (dimer)等のクラスター (cluster)が考えられ, その存在は吸収スペクトルにも反映されるものと期待 されるが,図8の蒸着膜でのスペクトルからこの事を

されるが,図8の蒸着膜でのスペクトルからこの事を 結論することはできない。しかしG発光に対する励起 スペクトルに於いて,X=1mol%では5.68eV吸収帯 でのみ強く励起されている(図5)のに対し,X=16 mol%ではその低エネルギー側の5.35eVの位置に肩 状の構造が現われ(図10),X=33mol%では5.68eV 吸収帯での位置より,低エネルギー側の領域で強く励 起されている事がわかる。この事は,濃度Xの増加に 伴い,孤立Br⁻による5.68eV吸収帯の低エネルギー 側にBr⁻クラスターによる吸収成分が成長しており, そこでの励起により,G発光が現われる事を示してい る。以上の事からG発光の原因としては孤立Br⁻及び 各種のBr⁻クラスターの存在が考えられ,これらによ る各発光成分の強度が濃度により変化する事により, 図7で示されている様なG発光の濃度依存性が生ずる ものと考えられる。なお,上記のBr⁻クラスターによ る吸収帯が孤立Br⁻による吸収帯の低エネルギー側に 現われる事は理論的⁽¹⁰⁾にも予想される事であり,ま たアルカリ ハライド系である KCI-KI 系⁽¹¹⁾, NaCI-NaBr系^(12,13)では実験的に確証されている。

UV発光及びY発光は高濃度領域で顕著に現われ, 図6及び図7からわかるように夫々,CdBr₂固有発光 の3.30eV発光帯及び2.15eV発光帯と密接に関係した ものである。この事より,これらはCdBr₂成分に関係 したバンド励起子⁽¹⁰⁾の緩和状態からの発光であると 推定される。図10,図11,図12に於て,UV発光が低 濃度(X=16mol%)では5.68eVの孤立Br⁻吸収の 低エネルギー側、即ち5.35eV近辺でのみ強く励起さ れており,濃度Xの増加に伴い,励起領域が低エネル ギー側へ広がると共に,高エネルギー側でも強く励起 されるようになるのは,吸収スペクトルに於けるバン ド励起子による成分が成長する事に対応しているもの と考えられる。

以上の考察に於いて, G発光は CdCl₂結晶中の孤立 Br⁻ 及び各種の Br⁻ クラスターによるものであり、 UV及びY発光は CdBr。成分に関するバンド励起子 によるものであると一応の同定を行ってきたが、この ように分類する事で発光,励起スペクトルの濃度依存 性及び発光の温度依存性が全て説明しうるわけではな い。まず第一に, G発光成分は75mol%以上の濃度 領域まで存在しているが, Br-及び Cl-のランダムな 分布を考えれば, 孤立 Br⁻ 及び各種Br⁻クラスターの 結晶中での存在率は,X=20mol%近辺で殆んど零に なる(10)事と矛盾する。また第二に, 励起スペクトル が,高濃度領域に於いては,G発光に対するものと UV発光に対するものとで同じ振舞いを示す(図12) 事が説明し切れない。これらの二点の困難はバンド励 起子の緩和に依ってもG発光が生じると考える事によ って一応回避され得るが、この点の詳細に立入る前に カドミウムハライドでの励起子の緩和状態に関する考 察を行う。

一般に絶縁体結晶に於いては, 正孔の有効質量が電 子のそれに比べて大きいため, 励起子の捕獲は主とし てその構成要素である正孔の捕獲によるものと考えら れる。従って緩和励起子状態を考えるにあたり, 結晶 に固有の正孔捕獲中心が何であるかを決めることが重 要になる。このような正孔捕獲中心に関してよく研究 されているものは、 アルカリハライドに於ける V_k 中心⁽¹⁴⁾と AgClに於ける Ag²⁺中心⁽¹⁵⁾である。

アルカリハライド混晶系である NaCl-NaBrに於い ては、Br-による二種類の発光が現われる⁽¹⁶⁾。即ち、 孤立 Br-による [BrCl-(V_k)+electron] 型の緩和 状態からの発光と、Br-ダイマー及び クラスターと NaBr 成分に関する バンド 励起子の緩和状態 [Br₂-(V_k)+electron] からの発光とである。 この系では 孤立Br-による発光は NaBr の濃度が20mol%近辺で 殆んど観測されなくなり、Br-ダイマーによる発光帯 が単調に移動して NaBrの固有発光帯になっている。 このような発光の濃度依存性は、励起子の緩和状態が [V_k中心+electron] 型のものである事⁽¹⁴⁾からの帰 結であるが、ここで問題にしている CdCl₂-CdBr₂ 混 晶に於けるG発光及びUV、Y発光の濃度依存性は明 らかに、このような緩和状態のモデルでは説明できない。

AgCl 結晶に於いては, 価電子帯の最上部は主とし て Cl⁻の3p 軌道からなっているが Ag+の 4d 準位がそ のすぐ下に存在するため,結晶が励起されると,正孔 と格子振動との強い相互作用により生ずる格子の歪み の結果, この 4d 準位が価電子帯の上に来る事に依り 正孔がAg+のまわりに捕獲されるものと考えられてい る⁽¹⁷⁾。この 4d 準位の存在及びそのエネルギー帯構造 への寄与は光電子スペクトルの解析からも示されてい る⁽¹⁸⁾。 AgCl-AgBr 系混晶に於いては, AgCl 型の 発光と AgBr 型の発光がAgBrの濃度65mol%近辺で 急激に入れかわる(19)が、この系では AgCl 中の Br-に依る不準物準位が母体の価電子帯と融合 してしま い⁽²⁰⁾, また, AgBr の固有発光が緩和励起子型では なく,自由励起子状態からのいわゆる共鳴型のもので ある⁽²¹⁾ため,ここでのCdCl₂-CdBr₂系混晶に於ける 場合と直接比較することはできない。

カドミウムハライド結晶に於ける固有の正孔捕獲中 心は未だ実験的に検出されていないが、その価電子帯 の最上部はハロゲンのp軌道からなっており、また Cd^{2+} は Ag^+ と等電子配置のイオンである事から、銀 ハライド、特に AgCl 結晶に於ける場合と類似したも のである事は十分に推定されうる。この仮定によれば 正孔は Cd^{2+} のまわりに捕獲される事にななるが、励 起子の緩和状態としては、固有発光及びハロゲン不純 物発光の振舞いがハロゲンイオンの種類に強く依存す る事を考え併せて、 Cd^{2+} のまわりの ハロゲンをも含 めた [$Cd^{2+}X_6^-$]型の分子状 イオンの励起状態(X^- はハロゲンイオン)を近似的なものとして考えるのが 適当であろう。なおカドミウムハライド結晶に於ける バンド構造に関する詳細な研究は殆んどなされていな いが、CdI₂に於いて Cd²⁺の d 準位の存在によると考 えられる間接遷移吸収端スペクトルが観測 されてい る^(22,23) 事と、光電子放出の実験により価電子帯に d準位による構造が現われる⁽²⁴⁾ 事より CdCl₂ 及び Cd Br₂に於いても d 準位の存在が正孔捕獲に主要な役割 を果すという上記の仮定は妥当なものと考えられる。

緩和励起子に対する上記の〔Cd²⁺X。⁻〕型の局在中 心を考えれば、CdCl2-CdBr2 混晶系に於ける発光の始 状態はX⁻の位置にCl⁻またはBr⁻が配位したものとな り,発光スペクトルの濃度依存性は X-の位置に対す る Br⁻の配位数に依るものと考えられる。即ち, Br⁻ 配位数が少ない場合はG発光となり、多い場合がUV またはY発光となる。この様に混晶系での発光に対す る同定を修正すると,前記の矛盾点は一応回避でき る。まず X=75mol%以上の高濃度領域に 於てもG 発光が現われるのは, CdBr2成分に関するバンド性の 励起子が Br-配位数の少ない位置で緩和する事に依る ものであり、高濃度領域でUV発光及びG発光に対す る励起スペクトルの形状が殆んど同じになるのは、光 学励起により生ずる励起子が共通のバンド励起子であ る事に依るものであると考えられる。更に低濃度領域 では、CdCl2 中の Br-またはそのクラスターが結晶中 で孤立しており、励起スペクトルには、それらによる 吸収スペクトルが反映され図10に見られる様なG発光 及びUV発光の励起位置に対する選択性が現われるも のと考えられる。またCdBr2に関するバンド励起子の 生成が少ないと考えられるX=16mol%に於いてUV 発光が比較的強く観測される(図7参照)のは、この 発光が高次のクラスターによる吸収の結果によっても 励起されうると考える事により説明できる。

G発光とUV及びY発光との間には、発光強度の温 度依存性に顕著な違いがある。即ち、G発光はLHeT からLNTまでの温度領域でその強度が殆んど変ら ないのに対して、UV発光及びY発光はLHeT から LNTの間で、その相対強度が互いに入れ換る。前者 のような温度依存性を示すものとしてはCdCl₂固有発 光、CdCl₂中のBr⁻またはI⁻によるハロゲン不純物発 光⁽⁵⁾があり、また後者のものとしてはCdBr₂母体発光 及びCdBr₂中のI⁻による発光^(5,6)がある。

このことより発光の温度依存性は母体結晶の種類に 依るものである事がわかり, G発光は CdCl₂型のまた UV及びY発光は CdBr₂ 型の発光である。従って濃 度XによるG発光からUVまたはY発光への変化は, CdCl₂型から CdBr₂ 型への変化であるが,同じ Cd Br₂型であってもUV発光とY発光の入れかわる温度 は濃度Xが小さい程低温になり,この現象は緩和状態 に関する上記の [Cd²⁺X₆-]型分子状イオンの励起状 態という近似では十分に説明できない。最近接の六個 のハロゲンイオンのみではなく,もっと広い範囲に拡 がった状態を考える必要があるものと考えられる。

5. 結 論

1) CdCl₂-CdBr₂混晶をCdBr₂成分に関する吸収帯 領域の紫外光で励起すると,三本の発光帯が観測され る。2.4~2.6eVの領域に現われる発光(G発光)は, CdBr₂の濃度Xの小さい領域で顕著に観測され,その 発光強度はLHeTとLNTの間で殆んど変化しない。 一方,2.1~2.2eVの領域に現われる発光(Y発光) は,CdBr₂濃度Xの大きい領域で強く観測され,また LNT で顕著である。このY発光はLHeT では消滅 し,代って3.3~3.6eVの領域に別の発光(UV発光) が現われる。

2) これらの発光帯の濃度依存性及びそれらに対す る励起スペクトルの振舞いは,カドミウムハライドに 於ける励起子の緩和状態として $[Cd^{2+}X_6^{-}]$ 型(X: ハロゲン)の局在中心を考える事により定性的には説 明できる。即ち, CdCl₂中の Br⁻またはそのクラスタ –及び CdBr₂ 成分に関するバンド励起子が,上記局 在中心のX⁻位置に配位する B,⁻の個数が少ない状態へ 緩和することによってG発光を出し,また CdCl₂中の 高次のクラスターまたは CdBr₂ 成分のバンド励起子 がX⁻位置に多くの Br⁻ が配位している状態へ緩和す ることにより、UVまたはY発光が放出されるものと 考えられる。

6. 謝辞

本研究には多量の液体ヘリウム及び液体窒素を使用 したが,その供給は福井大学超低温物性実験施設に負 った。八木寿郎教授を始め同実験施設の方々の御助力 に深く感謝致します。また実験装置の製作に 関して は,山田隆昇技官の貢献大なる事をここに記し,厚く 感謝の意を表します。

参考文献

1) H. D. Megaw : Crystal Structures (W. B. Saunders Company, Philadelphia, London,

Toronto, 1973) p. 94.

- T. Abe, H. Nakagawa and H. Matsumoto: Memoirs Fac. Eng. Fukui Univ. 23 (1975) 67.
- T. Kitamura, H. Nakagawa and H. Matsumoto : Memoirs Fac. Eng. Fukui Univ. 22 (1974) 217.
- H. Nakagawa, T. Abe and H. Matsumoto: J. Phys. Soc. Japan 40 (1976) 1363.
- 5) H. Matsumoto and H. Nakagawa : J. Luminescence 12 (1976) 403.
- T. Kitamura, H. Nakagawa and H. Matsumoto: Memoirs Fac. Eng. Fukui Univ. 23 (1975) 57.
- 7) H. L. Friedman : J. Chem. Phys. 24 (1952) 319.
- M. R. Tubbs : Phys. Stat. Solidi (b) 49 (1972) 11.
- 9) S. Kondo and H. Matsumoto : unpublished data.
- K. Cho and Y. Toyozawa : Proc. Int. Conf. Statistical Mechanics, Kyoto, 1968 ;
 J. Phys. Soc. Japan 26 (1969) Suppl. p. 71.
- N. Nagasawa : J. Phys. Soc. Japan 27 (1969) 1535.
- 12) H. Nakagawa, M. Itoh and Y. Nakai :J. Phys. Soc. Japan 32 (1972) 1037.
- 13) H. Nakagawa : J. Phys. Soc. Japan 34

(1973) 410.

- M. N. Kabler : Hole Centers in Halide Lattice in *Point Defects in Solid* ed. by J.
 H. Crawford Jr. and L. M. Slifkin (Plenum Press, New York, London, 1972) p. 327.
- M. Hohne and M. Stasiv : Phys. Stat. Solidi 28 (1968) 247.
- 16) H. Nakagawa, K. Toyoda and Y. NaKai : J. Phys. Soc. Japan 33 (1975) 1067.
- M. Fukui, Y. Hayashi and H. Yoshioka :
 J. Phys. Soc. Japan 34 (1973) 1226.
- M. G. Mason : Phys. Rev. B 11 (1975) 5094.
- H. Kanzaki, S. Sakuragi and K. Sakamoto: Solid State Commun. 9 (1971) 999.
- H. Kanzaki and S. Sakuragi : J. Phys. Soc. Japan 27 (1969) 109.
- H. Kanzaki and S. Sakuragi : J. Phys. Soc. Japan 23 (1970) 924.
- P. L. Greenaway and R. Nitsche : J. Phys. Chem. Solids 26 (1965) 1445.
- Y. Takamura, M. Komatsu and Y. Kaifu: Reported at the meeting of Phys. Soc. Japan, Autumn, 1974, 13a-Y-6.
- 24) T. Matsukawa, T. Ishii and T. Sagawa: Reported at the meeting of Phys. Soc. Japan, Spring, 1974, 3a-KH-11.